## INFORMATION DISCLOSURE CITATION

340-80

Atty. Docket No.

Applicant

Serial No.

10/686,520

SIPE

(Use several sheets if necessary)

KOCHERGIN et al.

TC/A.U.

16 October 2003

2872

2.	
<b>^</b>	.0
SN.	at-/
VA.	~**
~ \~ IF	ADEMA

			U.S. PATENT	DOCUMENTS					
*EXAMINER			0.0					FILING DATE	
INITIAL	DOCUMENT NUMBER	DATE		NAME	CLASS	SUBCLASS	IF APPR	OPRIATE	
		<u> </u>							
					<del>-  </del>				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
								•	
							ļ		
		<u></u>						·	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				· • · • • · · · · · · · · · · · · · · ·					
		FOI	REIGN PATEN	T DOCUMENTS					
								LATION	
	DOCUMENT	DATE		COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	YES	NO	
-									
	OTHER DOCL	IMENTS /ii	ncluding Auth	or, Title, Date, Pertine	nt pages el	lc )	l	_	
	H H Föll et al "Porous	III-V comp	ound semicondu	ctors: formation, properti	ies and comp	arison to sili	con" Phy	s Stat	
	Sol. A, 197 (1), pp. 61-7	0 (2003)		otoror rormation, propert	ios, and comp			o. Dian	
			195 (3), "Electro	chemical pore etching in	Ge," R4-R6 (	2003)			
	Macleod H.A., Thin-Fil.	m Optical Fi	ilters, 3rd ed., Ins	stitute of Physics Publishi	ing, 2001			<u>-</u>	
							<del></del>	····	
		•					<u></u>		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>				
							<del></del>	-	
*Examiner				Date Considered					